



博学而笃志 切问而近思

站内搜索: [搜索](#)



丁士进

系别: 微电子研究院
职称: 教授 研究员
职务:
办公室: 邯郸微电子学楼314室
电话: 55664845
E-mail: sjding@fudan.edu.cn
主页:

教育背景

7/1/2001 复旦大学 博士研究生
10/1/2001至11/1/2002 德国基尔(Kiel)大学做博士后研究 任Research Fellow of Alexander von Humboldt Foundation

研究方向

纳米结构闪存器件 MIM结构新器件 深亚微米集成电路互连工艺和材料 先进MOSFET材料与工艺

课程教学

本科课程: 深亚微米工艺技术
研究生课程: 微电子材料与工艺理论

学术兼职

美国电气工程师协会(IEEE)会员
论文评审人
国内期刊《半导体学报》、Chinese Physics Letters审稿人
International Symposium on Safety and Structural Integrity 2007技术委员会(上海.中国)委员
2008 9th International Conference on Solid-State and Integrated-Circuit Technology (October 20-23, Beijing China)程序委员会.委员

科研项目

教育部科学技术研究重点项目: 高密度金属性纳米晶的二维可控生长及其在存储器中的应用
新世纪优秀人才支持计划: 金属纳米晶存储器关键材料和工艺研究
重大专项项目子课题: 嵌入式闪存基础理论和新型材料的研究
重大专项项目子课题: 铅基、镉基高k栅介质材料及其原子层淀积关键制备技术
“973”项目子课题: 新型互连及基础问题研究

论文著作

1. Applied Physics Letters, 93(9), 092909 (2008), Electrical characteristics and conduction mechanisms of metal-insulator-metal capacitors with nanolaminated Al2O3-

HfO₂ dielectrics, , 93(9),

2. Journal of Physics D: Applied Physics, 41(3), 032007 (2008), Physical and electrical characterization of atomic-layer-deposited Ru nanocrystals embedded into Al₂O₃ for memory applications, , 41(3),

3. Applied Physics Letters, 91 (2), 022908 (2007) , Multistacked Al₂O₃/HfO₂/SiO₂ tunnel layer for high-density nonvolatile memory application, , 91 (2) ,

4. Journal of Applied Physics, 102 (7), 073706 (2007). , High temperature conduction behaviors of HfO₂/TaN-based metal-insulator-metal capacitors, , 102 (7),

5. Journal of Vacuum Science & Technology A, Investigation of atomic-layer-deposited ruthenium nanocrystal growth on SiO₂ and Al₂O₃ films, , 25(4), 775-780

6. Applied Physics Letters, 88, 042905 (2006). , High density and program-erasable metal-insulator-silicon capacitor with a dielectric structure of SiO₂/ HfO₂-Al₂O₃ nanolaminate/Al₂O₃, , ,

7. Applied Physics Letters, 87, 053501 (2005) , Atomic-layer-deposited Al₂O₃-HfO₂-Al₂O₃ dielectrics for metal-insulator-metal capacitor applications, , ,

8. IEEE Electron Device Letters, Evidence and Understanding of Atomic-Layer-Deposited HfO₂-Al₂O₃ Laminate MIM Capacitors Outperforming Sandwich Counterparts, , 25 (10), 681-683

9. IEEE Transactions on Electron Devices, RF, DC and Reliability Characteristics of Atomic Layer Deposited HfO₂-Al₂O₃ Laminate MIM Capacitors for Si RF IC Applications, , 51 (6) , 886-894

10. IEEE Electron Device Letters, High Performance MIM Capacitor using ALD high- κ HfO₂-Al₂O₃ Laminate Dielectrics, , 24 (12), 730-732

获奖情况

[返回](#)